



Транзисторы КТ312А,
КТ312Б,
КТ312В

ЭТИКЕТКА

Кремниевые эпитаксиально-планарные $N-P-N$ высококачественные транзисторы типов КТ312А, КТ312Б, КТ312В в металлочелюстном корпусе, предназначенные для работы в радиочастотных транзисторных, приемно-усилительной и другой радиотехнической аппаратуре.

Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69.



Масса не более 1г.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 25°C

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Нормы					
		КТ312А		КТ312Б		КТ312В	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
1	2	3	4	5	6	7	8
Обратный ток коллектора, μA ($U_{кз} = 20В$ для КТ312А, КТ312Б $U_{кз} = 36В$ для КТ312В)	$I_{кобр}$		10				10
Обратный ток эмиттера, μA ($U_{кз} = 4В$)	$I_{эобр}$		10		10		10
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером ($U_{кз} = 2В$, $I_{к} = 20мА$, $f = 50-10000Гц$, $\beta = 10-100$)	$h_{21э}$	10	100	25	100	50	280

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В ($I_k=20\text{мА}$, $I_b=2\text{мА}$)	$U_{кз нас}$	0,8	0,8	0,8
Напряжение насыщения базис-эмиттер, В ($I_k=20\text{мА}$, $I_b=2\text{мА}$)	$U_{бз нас}$	1,1	1,1	1,1
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ($U_{кз}=10\text{В}$, $I_b=0\text{мА}$, $f=20\text{МГц}$)	h_{213}	4	6	6
Граничное напряжение, В ($U_{кз}=20\text{В}$, $I_b=7,5\text{мА}$ для КТ312А, КТ312Б и $U_{кз}=35\text{В}$, $I_b=7,5\text{мА}$ для КТ312В)	$U_{кгр}$	20	35	20
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте, нс ($U_{кз}=10\text{В}$, $I_b=0\text{мА}$, $f=5\text{МГц}$)	T_k	500	500	500
Емкость коллекторного перехода, пФ ($U_{кз}=10\text{В}$, $f=5\text{МГц}$)	C_k	5	5	5
Емкость эмиттерного перехода, пФ ($U_{кз}=1\text{В}$, $f=5\text{МГц}$)	$C_э$	20	20	20

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ:

Золото 10,75 мг

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы типа КТ312А, КТ312Б, КТ312В соответствует
ГОСТ 11630-84 и «АО.336.674ТУ».

